PR0435

Ethylenedithio 型マクロサイクリック bis-TTF と TCNQ 誘導体からなる

電荷移動錯体ナノ構造の構築

(北大院環境科学¹、北大電子研²、CREST³) 遠藤格¹ 野呂真一郎^{1,2} 芥川智行^{1,2,3} 中村貴義^{1,2,3}

【緒言】

有機分子が形成する分子性ナノ材料は、ナノスケールの電子デバイス開発の有用な材料として 期待されている。我々は、テトラチアフルバレン(TTF)などの電子活性な 電子系に両親媒性を付 与することで電気伝導性のあるソフトマテリアルの作製に関する検討を行ってきた。これまでに、 エチレンジチオ型両親媒性マクロサイクリック bis-TTF 誘導体(1)のヨウ素錯体溶液にスピンコー ト法を適用することで、マイカ基板上にナノドットが作製可能であることを報告している。電子 スペクトルの結果から、ドット内でドナー(1)が完全電荷移動状態にあり、さらに導電性 AFM か ら、このナノドット構造は、伝導性ナノ材料としての高いポテンシャルを有していることを確認 している。このようなナノ構造の電荷移動状態を制御することが可能となれば、さらなる電気伝 導性の向上が期待できる。本研究では、置換基導入によりアクセプター性を調整した TCNQ 誘導 体(2)を用いて、(1)との電荷移動錯体を形成し、Langmuir-Blodgett 膜及びスピンコート膜を作製 し、そのナノ構造及び物性について検討を行った。



【実験方法】

各々の TNCQ 誘導体 2a~2e とドナー(1)を、それぞれクロロホルムとアセトニトリルの 8:2 混 合溶媒に溶解し、LB 膜の作製を行った。下層水に 0.01M KCl 水溶液を用いて表面圧 5 mN·m⁻¹ で単分子膜及び LB 膜の累積を行った。DFM を用いた表面構造の観測では、マイカ基板上に垂直 侵積法で 1 層累積を行い、UV スペクトルの測定には、石英基板上に水平付着法で 40 層累積を行 った。また、電気伝導度を測定するために、疎水化した PET フィルムに金電極(ギャップ 0.5 mm) を蒸着し、LB 膜を水平付着法で40 層累積し、2 端子法を用いて測定した。

【実験結果及び考察】

マイカ基板上に作製した(1)(F₄TCNQ)² 錯体の DFM 画像を図 2 に示す。高さが 1.2 nm のワイ ヤ状のドメインがみられた。電子スペクトルの結果から 11.2 × 10³、14.0 × 10³、25.7 × 10³ cm⁻¹ で F₄TCNQ のアニオンラジカルに相当するピークがみられた。同時に、分子 1 のカチオンラジカ ルに対応するピークが 20 × 10³ cm⁻¹ に現れた。F₄TCNQ アニオンラジカル由来の吸収は、基板に 対する入射角 45 ° の S 偏光のスペクトルにおいて強く現れたことから F₄TCNQ 分子の長軸方向 は、基板平面に対して比較的水平であると考えられる。



図 2: (1)(F₄TCNQ)₂の DFM 像



(1)(Br₂TCNQ)₂錯体をマイカ基板上に累積したところ、高さ1.1 nmの均一なドメインがみられ た(図4)。電子スペクトルから、11.1×10³と12.5×10³ cm⁻¹にBr₂TCNQのアニオンラジカルのピ ークが現れた。(1)(F₄TCNQ)₂ 錯体と同様な偏光依存性が出現したことからBr₂TCNQ分子の長軸 方向は、基板平面に対して比較的水平であると考えられる。また、(1)(Br₂TCNQ)₂錯体は、電子 スペクトルの結果から伝導性があることが示唆され、その300Kにおける電気伝導度は、約10⁻³ S/cmであった。当日は、F₂TCNQ、F₁TCNQ、Cl₂TCNQのLB膜、スピンコート膜についても併 せて報告を行う予定である。



図 4: (1)(Br₂TNCQ)₂の DFM 画像



図 5: (1)(Br₂TNCQ)₂の電子スペクトル